

## 4. Elektrische Eigenschaften von Metallen

### 4.1. Leitungselektronendichte und Eigenschaften von Metallen

Elektronen im Festkörper bewegen sich im Wesentlichen unabhängig voneinander - kollidieren nicht miteinander - ganz wie Nukleonen im Atomkern  $\approx$  wieder Behandlung als Fermigas. Effekt des Gitters: WW mit Phononen und Defekten

Wem Elektronen im Therm. Gleichgewicht (werden später prüfen, ob sie das sind)

$$\frac{1}{2} m_e v_T^2 = \frac{3}{2} k_B T \quad \text{mit } v_T = 10^5 \text{ m/s bei Raumtemp (seht Skala)}$$

Konzept von Leitungselektronen: jedes Atom trägt  $Z_v$  Valenzelektronen aus der äußersten nicht abgeschlossenen Schale zur metallischen Bindung, d. Leitung etc. bei  
mit Dichte der Atome  $\approx$  Leitungselektronendichte  
n Größenordnung  $10^{28} - 10^{29} / \text{m}^3 \approx \boxed{\text{Tab 4.1}}$

Messung der Leitungselektronendichte (und Ladungsvorzeichen!): Hall-Effekt (Hall 1879)

$$E_H = R_H j \times B_z$$

$$\hookrightarrow \text{Hall-Widerstand} = \frac{-1}{neZ_v} \approx Z_v \text{ aus } R_H$$

nicht schlecht für Alkali, Erdalkali, Al  
 aber: - Vorzeichen für  $\rho \approx$  offensichtlich  
 Leitung durch positive Ladungsträger  
 - Katastrophe Bi

elektrische Leitfähigkeit durch Bewegung der  
Ladungsträger

Bewegungsgleichung der Elektronen mit Kollisionen  
 (ohne externes Magnetfeld)

$$m_e \left( \frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{\vec{v}}{\tau} \right) = -e\vec{E} \quad \text{Driftgeschwindigkeit } \vec{v} \text{ der Elektronen; ist der thermischen Bewegung überlagert}$$

$$\vec{v} = - \frac{e\tau}{m_e} \vec{E} = -\mu_e \vec{E}$$

Mobilität der Elektronen

$$\text{Stromdichte } \vec{j} = -ne\vec{v} = \frac{ne^2\tau}{m_e} \vec{E} \quad \text{Ohmsches Gesetz}$$

$$\text{Leitfähigkeit } \sigma = \frac{1}{\rho}$$

charakteristische Relaxationszeit  $\tau$  (zeitl. Abstand  
 zwischen Kollisionen), bzw mittlere freie  
 Weglänge  $\lambda = v\tau$

in Metallen ist  $\sigma \approx 10^7 - 10^8 / \Omega \text{m}$  Fig 4-1

mit starker Temperaturabhängigkeit

in einfachem klassischen Drude-Modell  
 kollidieren Elektronen mit Atomrümpfen: typ  
 Abstand  $\approx \lambda \approx 1 \text{nm}$

mit thermischer Geschwindigkeit bei Raumtemp  
 ist etwa korrekt für  $\sigma$  für Alkali, Erdalkali

3. Hauptgruppe

abw: Edelmetalle leiten viel besser und Elemente der 5. Hauptgruppe viel schlechter

außerdem ist  $T$ -Abhängigkeit viel stärker als sich thermische Geschwindigkeit ändern würde.

→  $\tau$  ändert sich nicht wegen Geschwindigkeitsänderung ( $v \approx \text{konst}$ ) sondern Dichte der Kollisionspartner und Wirkungsquerschnitt ändern sich mit  $T$

Elektronen kollidieren mit Phononen und Gitterdefekten  $\frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau_{\text{ph}}(T)} + \frac{1}{\tau_0}$

$$\rho = \frac{m_e}{n e^2 \tau} = \underbrace{\frac{m_e}{n e^2 \tau_{\text{ph}}}}_{\text{ideale Resistivität}} + \underbrace{\frac{m_e}{n e^2 \tau_0}}_{\text{Restresistivität}}$$

→ Fig 4.2

optische Reflexivität von Metallen

behandeln Elektronen als frei, einfallendes osz.

E-Feld induziert Oszillationen und damit

Dipolmoment  $E(t) = E \exp(i\omega t) \Rightarrow x_e(t) = x_e \exp(i\omega t)$

und für freie Elektronen  $x_e = \frac{eE}{m_e \omega^2}$

Polarisation  $P = -n e x = -\frac{n e^2 E}{m_e \omega^2}$

$$\text{mit } \epsilon = 1 + \frac{P}{\epsilon_0 E} = 1 - \frac{n e^2}{\epsilon_0 m_e \omega^2} = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}$$

mit charakteristische Frequenz  $\omega_p = \sqrt{\frac{n e^2}{\epsilon_0 m_e}}$   
"Plasmafrequenz"

$\omega_p$  kann aus Elektronendichte  $n$  berechnet

werden. Vgl. mit Messung nicht schlecht Tab 4-1

beobachtet  $\epsilon$ : Licht mit  $\omega < \omega_p$  wird reflektiert ( $\epsilon$  reell und negativ,  $\sqrt{\epsilon}$  rein imaginär, erwidrigende Welle gedämpft, aber Elektronen als frei behandelt  $\leadsto$  kein inelastischer Prozess möglich, eine Welle muß reflektiert werden) das ist der Fall für sichtbares Licht  
 $\omega > \omega_p$   $\epsilon$  reell, positiv  $\leadsto$  eine Welle dringt in Material ein

Klassische Behandlung der Elektronen nicht gerechtfertigt. Kann man z.B. wie folgt sehen:  
 klassisch ist mittl.  $E_{\text{kin}} = \frac{3}{2} k_B T$   
 $\leadsto$  die Broglie Wellenlänge bei Raumtemp.  
 ( $v_f = 10^5$  m/s)  $\approx 6$  nm  
 vgl. mit mittlerem Abstand Atome und Gitter  
 Na:  $n = 2.7 \cdot 10^{28} / \text{m}^3 \leadsto d \approx 3$  nm  
 klassisch müsste  $\lambda \ll d$  sein  $\leadsto$

## 4.2 Fermi-Gas Modell

quantenmech. Behandlung unabhl. Elektronen  
 - Bewegung der Ionenrümpfe wesentlich langsamer (Masse)  $\leadsto$  Elektronen folgen adiabatisch der Bewegung (Oszillation) des Gitters effektiv sind Bewegungen separiert, Born-Oppenheimer Näherung  
 - berücksichtige keine Korrelation der Elektronen

für viele Metalle ist Potential für Elektronen klein (siehe unten)  $\rightarrow$  Elektronen fast frei

Teilchen im Kasten mit korrekter Randbed.  
 Born-von Karman  $\Psi(x, y, z) = \Psi(x+L, y, z) = \dots$   
 gelöst durch ebene Wellen  $\Psi(\vec{r}) = \frac{1}{\sqrt{V}} \exp(i\vec{k}\cdot\vec{r})$   
 mit Quasiverknüpfung  $\omega = \hbar k$  und  $E$   
 $\vec{k} = (k_x, k_y, k_z) = \left( \frac{n_x 2\pi}{L}, \dots \right)$  mit  $n_x, \dots$  ganzzahlig

$$E(\vec{k}) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m_e} = \frac{2\pi^2 \hbar^2}{m_e L^2} (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2) \quad \text{da } L \text{ makrosko-}$$

pisch ist Separation klein!

jeder Zustand kann wegen Spin 2 Elektronen ent-  
 halten, <sup>bei  $T=0$</sup>  alle gefüllt bis zu Fermienergie  $E_F$   
 und einer entsprechenden Quantenzahl  $n_{\max}$

$$\frac{N}{2} = \frac{4\pi}{3} n_{\max}^3 \quad E_F = \frac{2\pi^2 \hbar^2}{m_e L^2} n_{\max}^2 = \frac{2\pi^2 \hbar^2}{m_e} \left( \frac{3N}{8\pi L^3} \right)^{2/3}$$

$$= \frac{\hbar^2}{2m_e} (3\pi^2 n)^{2/3}$$

mittl. kin. Energie  $\langle E \rangle = \frac{3}{5} E_F$

$$\text{Zustandsdichte } g(E) = \frac{dN}{dE} = \frac{V}{2\pi^2} \left( \frac{2m_e}{\hbar^2} \right)^{3/2} E^{1/2}$$

bei endlicher Temp. folgt Beschreibung der Fermi-  
 Dirac Statistik

$$f(E, T) = \frac{1}{\exp\left(\frac{E-\mu}{k_B T}\right) + 1}$$

fi Metalle ist in guter Näherung  $\mu = E_F$

bei Raumtemp ist Beschreibung um ca.

100 meV um  $E_F$  ausgeschmückt

$$12\% \quad E_F + 2k_B T \quad 58\% \quad E_F - 2k_B T$$

typ Werte für  $E_F$  in Metallen einige eV

Geschwindigkeit Grössenordnung  $10^6 \frac{m}{s}$

$E_F \gg k_B T$  definieren  $T_F = E_F / k_B \sim$  einige  $10^4$  K  $>$  Schmelz-  
 temperatur

Fig. 4-3

Tab 4-2

## 4.2.2. Wärmekapazität - elektronische

da  $E_F \gg k_B T$ , nur kleiner Bruchteil ( $< 10\%$ ) der Elektronen, die in der Nähe der Fermienergie sind, können thermisch angeregt werden

in der Nähe der Fermienergie  $g(E_F) k_B T$  Elektronen mit mittlerer thermischer Energie  $\frac{3}{2} k_B T$

$$\langle E \rangle \text{ mittlere thermische Energie} = \frac{3}{2} k_B^2 T^2 g(E_F)$$

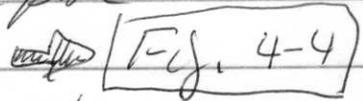
$$N = \frac{V}{3\pi^2} \left( \frac{2m_e E_F}{\hbar^2} \right)^{3/2} \quad \Rightarrow \quad g(E) = \frac{V}{2\pi^2} \left( \frac{2m_e}{\hbar^2} \right)^{3/2} E^{1/2} = \frac{3}{2} \frac{N}{E_F}$$

$$C_V = \left( \frac{d\langle E \rangle}{dT} \right)_V = 3 k_B^2 T g(E_F) = \frac{\pi^2}{2} \frac{k_B^2 T N}{E_F} = \frac{\pi^2}{2} k_B N \frac{T}{T_F}$$

pro Einheit Volumen  $\frac{\pi^2}{2} k_B n \frac{T}{T_F}$

Beitrag der Elektronen muß zu Phononenbeitrag addiert werden; da nur einige % der Elektronen beitragen  $\rightarrow$  auch in Metallen keine signifikante Abweichung von Dulong-Petit Regel

aber da Abfall  $\propto T$  (und für Phononen  $T^3$ ) ist elektr. Beitrag bei kleinem  $T$  maßgebend

 Fig. 4-4

Daten für Li, Na, K, Cu, Ag, Al sind in guter Übereinstimmung

für Übergangsmetalle Fe, Co, Ni exp. Faktor 10 größer  
kann man erst mit Bändermodell verstehen  
(d-d schmales Band, großer Beitrag zu  $N(E_F)$ )

Wärmeleitung (wie oben aus kin Gas Theorie)

$$\kappa = \frac{1}{3} C_V \lambda_e v_e \quad \text{mit } \lambda_e = v_e \tau$$
$$= \frac{1}{3} C_V \tau v_e^2$$

siehe für  $v_e$  Fermigesch. und  $C_V$  von oben erwi

$$\kappa = \frac{\pi^2}{3} \frac{k_B^2 n T \tau}{m_e}$$

NB: klassisches Gashoewergas  $\frac{1}{2} m_e v_e^2 = \frac{3}{2} k_B T$  und

$$C_V = \frac{3}{2} n k_B$$

$$\rightarrow \kappa = \frac{3}{2} \frac{k_B^2 n T \tau}{m_e}$$

aber  $C_V$  ist hier Faktor  $\frac{T_F}{T}$   
größer,  $v_e$  um selben Faktor kleiner  
 $C_V v_e$  etwa gleich

Verhältnis Wärmeleitung: el. Leitfähigkeit

$$\kappa = \frac{1}{3} C_V \tau v_e^2 = \frac{2}{3} C_V \tau E_F / m_e$$

$$\frac{\kappa}{\sigma} = \frac{2 E_F C_V}{3 n e^2} = \frac{\pi^2}{3} \frac{k_B^2}{e^2} T = L \cdot T \quad \text{Wiedemann-Franz Gesetz 1853}$$

bei gegebener Temp ist  $\kappa/\sigma$  konstant für alle Metalle

$$\text{Lorenz } \kappa/\sigma = L T$$

$$\text{Lorenzzahl } L = \frac{\pi^2}{3} \frac{k_B^2}{e^2} = 2.45 \cdot 10^{-8} \text{ W}\Omega/\text{K}^2$$

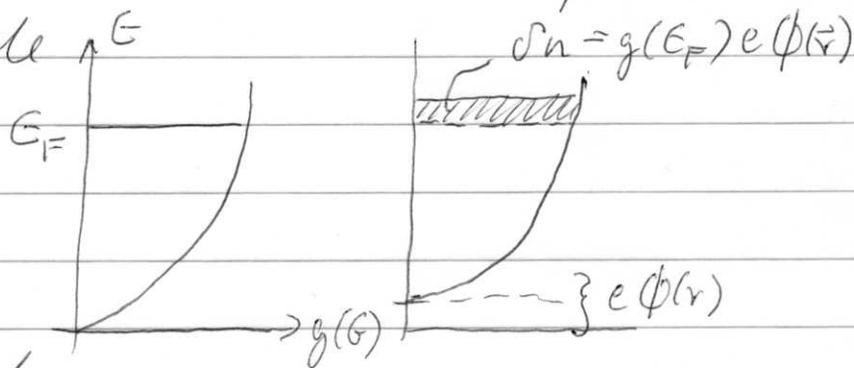
in gut übereinstimmung mit Daten für alle Metalle

### 4.2.3. Elektrostatische Abschirmung im Fermi-Gas / Mott-Übergang

Das Elektronengas reagiert auf lokale Ladungsdichte durch Abschirmung; je nach Ladungsvorzeichen fließen Elektronen an die Stelle des Defekts (wenn positiv) oder davon weg.

einfaches Modell: Ladungsdefekt entspricht lokalem Störpotential  $\phi(\vec{r}) \sim$  verschiebt Nullpunkt der Elektronenzustände  $\epsilon$

an Stelle nahe Defekt  $\epsilon_F$   
 $\delta n$  Elektronendichte zu hoch  
 Elektronen fließen weg, um überall gleiche Fermioberfläche zu garantieren



mit Poissongleichung  $\nabla^2 \phi(\vec{r}) = \frac{e}{\epsilon_0} \delta n = \frac{e^2}{\epsilon_0} g(\epsilon_F) \phi(r)$   
 bei sphärischer Symmetrie hier gelöst mit

$$\phi(r) = \frac{e}{4\pi\epsilon_0 r} \exp(-r/r_{TF})$$

mit  $r_{TF} = (e^2 g(\epsilon_F) / \epsilon_0)^{-1/2}$  Thomas-Fermi-Abschirmungslänge

$$\text{im Fermigas } \frac{1}{r_{TF}^2} = \frac{3ne^2}{2\epsilon_0 \epsilon_F} = \frac{4(3\pi^2)^{1/3}}{\pi} \frac{n^{1/3}}{a_0}$$

$$\text{mit Bohr radius } a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2 c^2}{m_e c^2 e^2} \approx 0.5 \cdot 10^{-10} \text{ m}$$

$\sim$  Abschirmung sehr effektiv!

Fig 4-5

dieselbe Abschirmung ist auch für die regulären

Atomrümpfe effektiv  $\leadsto$  reduziert dramatische Reichweite des attraktiven Coulombpotentials

$\leadsto$  führt erst dazu, daß Valenzelektronen im Metall nicht lokalisiert sind "leitungsrelevant"

je wirksamer Abschirmung, desto stärker Lokalisierung des Potentials und die Elektronenzustände über Ausdehnungrelation wächst Fermis (und Fermi)

$\leadsto$  Zustände werden energetisch angehoben, bis die obersten nicht mehr gebunden sind, d.h. sich frei bewegen  $\leftrightarrow$  Metall-Übergang zwischen Leiter und Isolator bei einer kritischen Elektronendichte

Abschätzung: gebundene Zustände in abgeschirmtem Potential wenn  $r_{TF} > a_0$

$$r_{TF}^2 \approx \frac{1}{4} \frac{a_0}{n^{1/3}} > a_0 \quad \text{oder} \quad n^{-1/3} > 4a_0$$

wenn mittlere Abstand zwischen Elektronen signifikant größer als  $4a_0 = 2\text{Å}$  erwartet man scharfen Übergang zu Isolator

sichtbar in Materialien wo über Materialzusammensetzung Elektronendichte variiert werden kann (Übergangsmetall oxyde, Gläser, dotierte Halbleiter)

4-10

## 4.2.4 Elektronische Wärmeleitung vs. elektrische Leitfähigkeit

Wärmeleitfähigkeit  $\Lambda = \frac{1}{3} \cdot c_V \cdot v \cdot l$  kinetische Gastheorie

$$\Lambda^{el} = \frac{1}{3} c_V^{el} \cdot v_F \cdot l$$

$$c_V^{el} = \frac{\pi^2}{3} \frac{\overset{\text{e-Dichte}}{\downarrow} 3mk_B}{2} \cdot \frac{T}{T_F} = \gamma \cdot T$$

↑ Sommerfeld-Konstante ( $2 \text{ mJ/mol K}^2$  bei Kalium)

$$T_F = \frac{\hbar^2}{2mk_B} (3\pi^2 n)^{2/3} \quad \text{Fermi-Temperatur}$$

$$v_F = \frac{\hbar}{m} (3\pi^2 n)^{1/3}$$

$$\} \Rightarrow \Lambda^{el} = \frac{1}{3} \frac{\pi^2 m k_B^2}{m \cdot v_F^2} \cdot v_F \cdot l_{\Lambda}$$

↙ freie Weglänge

$$\text{el. Leitfähigkeit } \sigma = \frac{ne^2}{m} \cdot \tau = \frac{ne^2}{m} \cdot \frac{l_{\sigma}}{v_F}$$

↙ freie Weglänge

Falls  $l_{\Lambda} = l_{\sigma}$ , d.h. freie Weglänge vom selben Streumechanismus bestimmt, dann

$$\boxed{\frac{\Lambda^{el}}{\sigma} = \frac{\pi^2}{3} \frac{k_B^2}{e^2} \cdot T = L \cdot T}$$

Wiedemann-Franz-Gesetz

$$L = 2,5 \cdot 10^{-8} \frac{\text{W}\Omega}{\text{K}^2} \quad \text{Lorentz-Zahl}$$

### 4.3 Elektronen im schwachen periodischen Potential

!  $10^{-10} \Omega \text{ cm} < \rho < 10^{22} \Omega \text{ cm}$ , Leitfähigkeit variiert bei den bekannten Festkörper über mehr als 30 Größenordnungen.

#### 4.3.1 Bloch-Funktion: Elektronenwelle + Gitterperiodizität

(a) periodisches Gitterpotential  $\tilde{V}(\vec{r}) = \tilde{V}(\vec{r} + \vec{R})$ ,  $\vec{R}$  Gittervektor

$$\tilde{V}(\vec{r}) = \sum_{\vec{G}} \tilde{V}_{\vec{G}} e^{i\vec{G}\vec{r}} \quad \text{Fourier-Entwicklung nach rezipr. Gittervektoren } \vec{G}$$

(b) Wellenfunktion Elektron (Einkristall-Näherung)

$$\psi(\vec{r}) = \sum_{\vec{k}} c_{\vec{k}} e^{i\vec{k}\vec{r}}$$

(c) Schrödinger-Gleichung

$$H \psi(\vec{r}) = \left[ -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta + \tilde{V}(\vec{r}) \right] \psi(\vec{r}) = E \psi(\vec{r})$$

Setze (a), (b) in (c) ein

$$\sum_{\vec{k}} \frac{\hbar^2 k^2}{2m} c_{\vec{k}} e^{i\vec{k}\vec{r}} + \sum_{\vec{k}', \vec{G}} c_{\vec{k}'} \tilde{V}_{\vec{G}} e^{i(\vec{k}' + \vec{G})\vec{r}} = E \sum_{\vec{k}} c_{\vec{k}} e^{i\vec{k}\vec{r}}$$

$\underbrace{\vec{k}' + \vec{G} \rightarrow \vec{k}}$

$$\Rightarrow \sum_{\vec{k}} e^{i\vec{k}\vec{r}} \left[ \left( \frac{\hbar^2 k^2}{2m} - E \right) c_{\vec{k}} + \sum_{\vec{G}} c_{\vec{k}-\vec{G}} \tilde{V}_{\vec{G}} \right] = 0$$

Das gilt  $\forall \vec{r} \Rightarrow$

$$\left( \frac{\hbar^2 k^2}{2m} - E \right) c_{\vec{k}} + \sum_{\vec{G}} c_{\vec{k}-\vec{G}} \tilde{V}_{\vec{G}} = 0$$

Schrödinger-Gleichung für  $e^-$  im periodischen Potential

$\Rightarrow$  einfacher(!), da nur noch Entwicklungskoeffizienten vom Typ  $c_{\vec{k}-\vec{G}}$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \psi_{\vec{k}}(\vec{r}) &= \sum_{\vec{G}} c_{\vec{k}-\vec{G}} e^{i(\vec{k}-\vec{G}) \cdot \vec{r}} \\ &= \left( \sum_{\vec{G}} c_{\vec{k}-\vec{G}} e^{i\vec{G} \cdot \vec{r}} \right) \cdot e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} \end{aligned}$$

$$\boxed{\psi_{\vec{k}}(\vec{r}) = u_{\vec{k}}(\vec{r}) \cdot e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}}} \quad \text{Bloch-Funktion}$$

$$\psi_{\vec{k}+\vec{G}}(\vec{r}) = \psi_{\vec{k}}(\vec{r})$$

Es gilt damit

$$H \psi_{\vec{k}} = E_{\vec{k}} \psi_{\vec{k}}$$

$$H \psi_{\vec{k}} = E_{\vec{k}+\vec{G}} \psi_{\vec{k}}$$

}

$$\boxed{E_{\vec{k}} = E_{\vec{k}+\vec{G}}}$$

### 4.3.2 Näherung des leeren Gitters

$$\bullet \quad E_{\vec{k}} = E_{\vec{k} + \vec{G}} = \frac{\hbar^2}{2m} |\vec{k} + \vec{G}|^2$$

Periodizität des Gitters erzwingt Periodizität der Eigenwerte der Schrödingergleichung

ABER: Da  $\vec{V}_G \approx 0$  keine Energiverschiebung

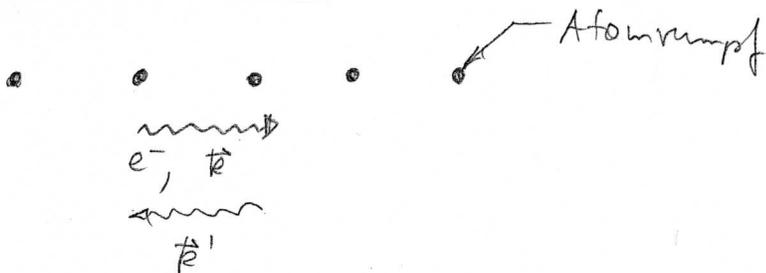
Bild: Näherung des leeren Gitters 4.6

1. BZ nicht!  $\Rightarrow$  Reduziertes Zonenschema

Bilder: Reduziertes Zonenschema 4.7 + Bänder 4.8

### 4.3.3 Schwaches periodisches Potential

Bsp. lin. Kette



Bragg-Reflexion, wenn Streuvektor  $\vec{k} = \vec{G}$ , rez. G.V.

$$\text{also } \vec{k} = \vec{k}' - \vec{k} = -2\vec{k} \quad \text{bzw.} \quad |\vec{k}| = \pm \frac{|\vec{G}|}{2} = \pm \frac{\pi}{a}$$

$\uparrow$  BZ-Rand

Fokus auf BZ-Rand  $k = \pm \frac{\pi}{a}$

einlaufende Welle  $\psi_1 \propto e^{i\pi \frac{x}{a}}$

rücklaufende Welle nach Bragg-Reflexion  $\psi_2 \propto e^{-i\pi \frac{x}{a}}$

2 Überlagerungsmöglichkeiten

$$\psi_s \propto \psi_1 + \psi_2 \propto \cos\left(\pi \frac{x}{a}\right)$$

$$\psi_a \propto \psi_1 - \psi_2 \propto \sin\left(\pi \frac{x}{a}\right)$$

}  $\Rightarrow$  räumlich modulierte Ladungsdichte

$$\rho_s = e |\psi_s|^2 \propto \cos^2\left(\pi \frac{x}{a}\right)$$

$$\rho_a = e |\psi_a|^2 \propto \sin^2\left(\pi \frac{x}{a}\right)$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{Bem.} \\ \rho_{\text{frei}} = e |\psi_1|^2 = \text{const.} \end{array} \right\}$$

Bei  $\varphi_s$  : Dichte im Kernnähe erhöht

↳ Absenkung der Energie

$\varphi_a$  : Dichte im Kernnähe abgesenkt

↳ Anhebung der Energie

Schrödinger-Gleichung : 2 Lösungen mit unterschiedlicher  
Energie am BZ-Rand  
→ Energielücke.

### Zwei-Komponenten-Näherung

$$\left\{ \begin{array}{l} \left( \frac{\hbar^2 k^2}{2m} - E \right) c_{\vec{k}} + \tilde{V}_{\vec{g}} c_{\vec{k}-\vec{g}} = 0 \\ \left( \frac{\hbar^2 |\vec{k}-\vec{g}|^2}{2m} - E \right) c_{\vec{k}-\vec{g}} + \tilde{V}_{-\vec{g}} c_{\vec{k}} = 0 \end{array} \right. \quad \left. \begin{array}{l} \uparrow \\ \text{kleinster reell. G.V.} \end{array} \right\}$$

$$\tilde{V}_{\vec{g}} = \tilde{V}_{-\vec{g}}$$

Am BZ-Rand gilt

$$E_s = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} + |\tilde{V}_{\vec{g}}|$$

$$E_a = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} - |\tilde{V}_{\vec{g}}|$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{sym. Überlagerung} \\ \text{antisym.} \end{array} \right\} \underline{\underline{\Delta E = 2 \cdot |\tilde{V}_{\vec{g}}|}}$$

Bild: 2-Komponenten-  
Näherung 4.9

4.4 Stark gebundene ElektronenBisher: weitgehend freie  $e^-$ 

Jetzt: Ausgangspunkt isolierte, einzelne Atome

$$SG: H_A \psi_i = E_i \psi_i$$

Überlapp der elektronischen Wellenfunktionen

Ein-Elektron Näherung

Bild: Modell stark gebundener Elektronen  
-4.10

Hamilton-Op. eines Elektrons, das sich im Potential aller Atome des Kristalls bewegt:

$$H = H_A + H_S$$

$$= -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta + \tilde{V}_A(\vec{r} - \vec{R}_m) + H_S(\vec{r} - \vec{R}_m)$$

$$H_S(\vec{r} - \vec{R}_m) = \sum_{n \neq m} \tilde{V}_A(\vec{r} - \vec{R}_n)$$

↑  
Lage des  
Störatoms  $n$

Störpotential

$$\psi_{\vec{k}} \approx \phi_{\vec{k}} = \sum_m a_m \tilde{\psi}(\vec{r} - \vec{R}_m) \quad \text{lineare Superposition der Atomorbitale}$$

Ansatz → Block: 
$$\phi_{\vec{k}} = \frac{1}{N} \sum_m \tilde{\psi}(\vec{r} - \vec{R}_m) e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}_m} \quad \text{Ansatz}$$

$$E_{\vec{k}} = \frac{\int \psi_{\vec{k}}^* H \psi_{\vec{k}} dV}{\int \psi_{\vec{k}}^* \psi_{\vec{k}} dV} \approx \frac{1}{N} \sum_{m,n} e^{i\vec{k} \cdot (\vec{R}_n - \vec{R}_m)} \int \dots$$

$$\dots \tilde{\psi}^*(\vec{r} - \vec{R}_n) \left[ H_A + H_S(\vec{r} - \vec{R}_m) \right] \tilde{\psi}(\vec{r} - \vec{R}_m) dV$$

4-16

$$\left. \begin{aligned}
 & \int \tilde{\psi}^* H_x \tilde{\psi} dV \quad \text{bekannt nach Voraussetzung} \\
 \alpha_i & := - \int \tilde{\psi}^* (\vec{r} - \vec{R}_m) H_x (\vec{r} - \vec{R}_m) \tilde{\psi} (\vec{r} - \vec{R}_m) dV \\
 \beta_i & := - \int \tilde{\psi}^* (\vec{r} - \vec{R}_m) H_x (\vec{r} - \vec{R}_m) \tilde{\psi} (\vec{r} - \vec{R}_m) dV
 \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$\begin{aligned}
 E_{\vec{k},i} & \approx \frac{1}{N} \sum_{m,n} e^{i\vec{k} \cdot (\vec{R}_m - \vec{R}_n)} (E_i - \alpha_i - \beta_{in}) \\
 & = E_i - \alpha_i - \sum_n \beta_{in} e^{i\vec{k} \cdot (\vec{R}_m - \vec{R}_n)}
 \end{aligned}$$

Für kubisch primitives Gitter

$$E_{\vec{k},i} \approx E_i - \alpha_i - 2\beta_i \left( \cos(k_x a) + \cos(k_y a) + \cos(k_z a) \right)$$

## 4.5 Energiebänder - Metalle - Isolatoren - Halbleiter - Halbmetalle

$N$  wechselwirkende Atome:

s-Elektronen:  $2 \cdot N$  Zustände pro Band

p-Elektronen:  $2 \cdot 3 \cdot N = 6N$  — " —

Bsp.  $1 e^-$  pro Atom, s-Zustand  $\rightarrow N e^-$  im s-Band,  
Platz wäre (Spin!) für  $2N \rightarrow$  halbefülltes Band

$\rightarrow$  einfache Metalle (z.B. Kalium)

Bild: Energiebänder  
Bsp. Einwertiges Metall  
4.11

$2e^-$  pro Atom (s), gefülltes Band  $\rightarrow$  Isolator  
Bandlücke zum nächsten unbesetzten Band typ.  $> 3eV$ .

Bild: Isolator 4.12

Halbmetalle: Bandüberlapp in versch. Kristallrichtungen (3d)  
Bsp. Wismut

Halbleiter: wie Isolator, Bandlücke typ.  $< 3eV$   
Bsp. Silizium, Germanium, GaAs, InP, ...

Bild: Energiebänder  
Halbmetalle  
4.13

## 4.6. Elektronen in Bändern

Gruppengeschwindigkeit

$$\begin{aligned}\dot{\vec{r}} &= \vec{v}_m(\vec{k}) = \frac{1}{\hbar} \vec{\nabla}_{\vec{k}} E_n(\vec{k}) \\ &= \frac{1}{\hbar} \frac{\partial E_n(\vec{k})}{\partial \vec{k}}\end{aligned}$$

Semiklassische Bewegungsgleichung

$$\hbar \dot{\vec{k}} = -e \left( \vec{E}(\vec{r}, t) + \vec{v}_m(\vec{k}) \times \vec{B}(\vec{r}, t) \right)$$

$$\begin{aligned}\dot{\vec{v}} &= \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{1}{\hbar} \frac{\partial E(\vec{k})}{\partial \vec{k}} \right) \\ &= \frac{1}{\hbar} \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{1}{\hbar} \frac{\partial E(\vec{k})}{\partial \vec{k}} \right) \hbar \dot{\vec{k}} \\ &= \frac{1}{\hbar^2} \frac{\partial^2 E(\vec{k})}{\partial \vec{k} \partial \vec{k}} \vec{F}\end{aligned}$$

Komponente  $i$

$$\dot{v}_i = \frac{1}{\hbar^2} \sum_j \frac{\partial^2 E(\vec{k})}{\partial k_i \partial k_j} F_j = \sum_j \left( \frac{1}{m^*} \right)_{ij} F_j$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{\left( \frac{1}{m^*} \right)_{ij} = \frac{1}{\hbar^2} \frac{\partial^2 E(\vec{k})}{\partial k_i \partial k_j}}}$$

$[m^*]$  Tensor  
der effektiven Masse

4-19

## 4.7 Elektronen und Löcher

Volles Band  $\sum \vec{k} = 0$ , Summe über alle Wellenvektoren der Elektronen verschwindet

Entferne 1 Elektron aus dem Band

$$\sum \vec{k} = -\vec{k}_m$$

$\uparrow$  n: neg. Ladungsträger: Elektron

Ordne dem fehlenden Elektron den Impuls

$$\vec{k}_p = -\vec{k}_m \quad \text{zu.}$$

Nenne das fehlende Elektron Loch.

Bild 4.15 Löcher & Elektronen

Zudem gilt  $E_p(\vec{k}) = -E_m(\vec{k})$   
Lochennergie = - Elektronenenergie

$$\begin{aligned} \left[ \frac{1}{m^*} \right]_p &= \frac{1}{\hbar^2} \left[ \frac{\partial^2 E(\vec{k})}{\partial \vec{k} \partial \vec{k}} \right]_p = \frac{1}{\hbar^2} \left[ \frac{\partial^2 E(\vec{k})}{(-\partial \vec{k}) (-\partial \vec{k})} \right]_n \\ &= - \left[ \frac{1}{m^*} \right]_n \quad \text{eff. Masse } m^* \end{aligned}$$

also  $m_p^* = -m_n^*$

4-20

Gruppengeschwindigkeit:  $\vec{v}_p(\vec{k}_p) = \vec{v}_n(\vec{k}_n)$ , denn

$$\vec{\nabla}_{\vec{k}_p} E_p(\vec{k}_p) = -\vec{\nabla}_{\vec{k}_n} (-E_n(\vec{k}_n)) = \vec{\nabla}_{\vec{k}_n} E_n(\vec{k}_n)$$

Bewegungsgleichung im äußeren  $\vec{B}$ ,  $\vec{E}$ -Feld

$$\hbar \dot{\vec{k}}_n = -e (\vec{E} + \vec{v}_n \times \vec{B})$$

$$\hbar \dot{\vec{k}}_p = +e (\vec{E} + \vec{v}_p \times \vec{B})$$

Beim Stromtransport:  $n, p$  in entgegengesetzte Richtung,  
da sich Elektron ( $n$ ) an der Unterkante des Leitungsbandes  
Löcher ( $p$ ) an der Oberkante des Valenzbandes  
aufhalten. Gradientenbildung!